
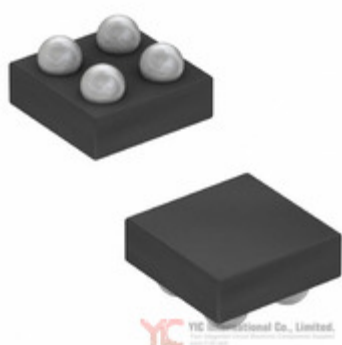
	<p><b>SI8487DB-T1-E1</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI8487DB-T1-E1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V MICROFOOT</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI8487DB-T1-E1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI8487DB-T1-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V MICROFOOT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta), 2.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2240pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI8487DB-T1-E1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI8487DB-T1-E1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI8487DB-T1-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI8487DB-T1-E1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI8483DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 16A MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8489EDB-T2-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8481DB-T1-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 9.7A 4- MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8481DB-T1-E1</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 9.7A 4- MICROFOOT</p>
 <p><b>SI8489EDB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8499DB-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8487DB-T1-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V MICROFOOT</p>	 <p><b>SI8497DB-T2-E1</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 13A MICROFOOT</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI8487DB-T1-E1 Vishay / Siliconix	SI8487DB-T1-E1 Datenblatt	SI8487DB-T1-E1-Datenblätter	SI8487DB-T1-E1 PDF	Vishay / Siliconix SI8487DB-T1-E1
SI8487DB-T1-E1 Electronic	SI8487DB-T1-E1-Komponenten	SI8487DB-T1-E1-Verteiler	SI8487DB-T1-E1-Bild	SI8487DB-T1-E1-Teil
SI8487DB-T1-E1 Preis	SI8487DB-T1-E1 Hersteller	SI8487DB-T1-E1 Bild	SI8487DB-T1-E1 Aktie	SI8487DB-T1-E1 Inventar
SI8487DB-T1-E1 Neu	SI8487DB-T1-E1 Original	SI8487DB-T1-E1 garantiert	SI8487DB-T1-E1 RFQ	SI8487DB-T1-E1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited